

北海道大学工学部 ○熊本敏昭 原 聰 柴田隆行 高橋義美 牧野英司 池田正幸

## 要旨

レーザ P V D 法において、 $\text{SiO}_2$ および $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットに関する熱解析、および蒸着実験を行った。その結果、平滑な $\text{Al}_2\text{O}_3$ 膜表面を得るためには、ターゲットに対して、スポットを絞ったレーザ照射が有効なことが推測できた。

## 1.はじめに

レーザが照射されたときの溶融・蒸発過程について、 $\text{SiO}_2$ および $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットに関する温度解析と蒸着実験の両側面から検討を行った。その結果をもとに、レーザ P V D 法におけるターゲット材質の熱物性値が、形成される膜の表面性状に及ぼす影響について考察した。

## 2. 解析方法および実験方法

解析に用いた計算モデルは、平板ターゲット（ $50 \times 50\text{mm}$ 、奥行きは単位長さ）を仮定した（図2、4参照）。ただし、温度分布はレーザ入射方向中心軸に対して対称と仮定し、半平面のみを計算した。熱伝導には熱伝導方程式（2次元）

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = a \left( \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial y^2} \right)$$

を離散化して用い、レーザによる熱流速は、半径方向の距離  $r$  の関数として

$$I(r) = \frac{2P}{\pi w^2} \exp \left( -\frac{2r^2}{w^2} \right)$$

で与えた<sup>1)</sup>。ここで、 $\theta$ : 温度（°C）、 $a$ : ターゲットの熱拡散率、 $P$ : レーザ出力（W）、 $w$ : スポット半径である。表1は計算で用いたターゲットの熱物性値である。また、蒸着実験に用いた装置は、前報のとおりである<sup>2)</sup>。

表1 解析に用いた熱定数

	熱伝導率 (W/m·K)	熱拡散率 (mm <sup>2</sup> /s)	融点 (°C)	沸点 (°C)
$\text{SiO}_2$	2.17	0.89	1710	2230
$\text{Al}_2\text{O}_3$	10.4	2.29	2050	2980

## 3. 結果と考察

## 3.1 蒸着膜表面性状

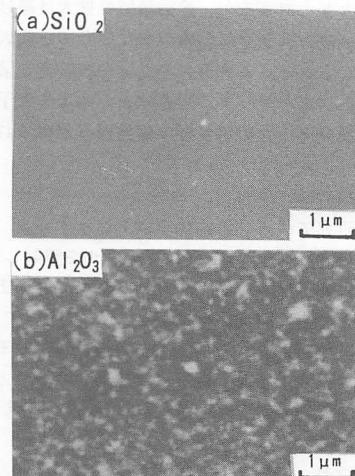
図1(a)(b)は、レーザ出力80W、スポット半径0.5mmの条件で形成された、 $\text{SiO}_2$ および $\text{Al}_2\text{O}_3$ 膜の表面SEM写真である。この図から、 $\text{SiO}_2$ 膜の表面は非常に平滑であるが、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 膜の表面には一面に粒子が見られ、その表面性状は非常に悪いことがわかる。

## 3.2 ターゲット材質が溶融・蒸発機構に及ぼす影響

図2(a)(b)は、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットにレーザ照射した場合、各々が沸点に達したときの温度分布の解析結果である。照射条件は3.1同様レーザ出力80W、スポット半径0.5mmである。なお、このときのレーザパワー密度は $1.02 \times 10^4 \text{ W/cm}^2$ である。

図から、 $\text{SiO}_2$ に比べ $\text{Al}_2\text{O}_3$ の方が温度分布の広がりは大きく、ターゲット内部への熱伝導がより進んでいることがわかる。

図3は照射時間に対するターゲットの中心温度の変化を示したグラフである（曲線AとB）。グラフ中丸印が打たれている点はターゲットの融点である（ $\text{SiO}_2$ は●、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ は○）。また、曲線が途切れる時点での中心温度が、各々のターゲットの沸点を示している。この図から、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットが沸点に達するまでの時間は、

図1  $\text{SiO}_2$ および $\text{Al}_2\text{O}_3$ 膜表面性状

$\text{SiO}_2$ に比べ長いことがわかる。

以上のことから、 $\text{SiO}_2$ ターゲットではレーザ照射後、短時間のうちに沸点に達するため、昇華に近い現象でターゲットからの除去が進行するものと推測される。これに対して、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットでは、熱拡散率が大きく、また、沸点も高いため、拡大した溶融領域において沸騰現象が生じると考えられる。したがって、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ での蒸発過程では、溶融領域の沸騰によって、比較的粒径の大きい溶融粒子が飛散し、これらが基板上に堆積することによって膜の表面性状が悪化するものと思われる。

### 3.3 レーザパワー密度の影響

$\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットに、パワーを 120 W に上げ、スポット半径を 0.5 mm のままにしてレーザ照射した場合と、レーザ出力を 80 W にしたままスポット半径を 0.3 mm に絞った場合との解析を行った。このとき、各々のパワー密度は  $1.53 \times 10^4 \text{ W/cm}^2$ 、 $2.83 \times 10^4 \text{ W/cm}^2$  となり、両者ともパワー密度が上昇する。図 3 の曲線 C, D は、そのときのターゲット中心の昇温速度、そして、図 4 (a)(b) が、

図 2 Si<sub>2</sub>およびAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ターゲットにおける温度分布

温度分布の解析結果である。

図 3 から、曲線 C, D とも曲線 B に比べ昇温速度は大きくなっているのがわかる。また、図 4 を図 2 (b) と比べると、図 4 (a) の場合、深さ方向の熱拡散は若干抑えられているが、表面では大差がない。これが、図 4 (b) の場合では双方とも熱の広がりは抑えられているのがわかる。

実際に、現在の実験装置で可能なスポット半径 0.5 mm で、レーザ出力 150 W による蒸着実験を行って  $\text{Al}_2\text{O}_3$  膜を形成したが、その表面は、レーザ出力を上げる前（図 1 (b)）と変化はなく、平滑なものとはならなかった。

以上のことから、パワーを上昇させることによって昇温速度は大きくできるが、溶融領域の拡大は避けられず、溶融粒子の飛散を抑制する効果が少ないため、膜表面性状は改善されないと考えられる。一方、スポットを絞ると、溶融領域を狭い状態にしたまま、ターゲットからの除去が始まると予想されることから、平滑な膜を得るために良好な蒸発過程が得られるものと推測される。

### 4. おわりに

本研究で得られた結論を以下に示す。

1)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットでは、レーザを照射してから沸点に至るまで、 $\text{SiO}_2$ に比べ長い時間がかかり、また、熱の広がりも大きくなる。このことから、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ターゲットの蒸発過程では、溶融領域での沸騰が生じ、粒径の大きい溶融粒子の飛散が生じるものと思われる。

2) スポットを絞ったレーザ照射をすることによって、溶融領域の拡大を抑えることができ、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 膜表面性状の改善に有効であると考えられる。

### 参考文献

- 1) 高岡隆、高橋忠：レーザ技術入門、秋葉出版(1986)85。
- 2) 原ほか：精密工学会北海道支部学術講演会講演論文集(1991)25。

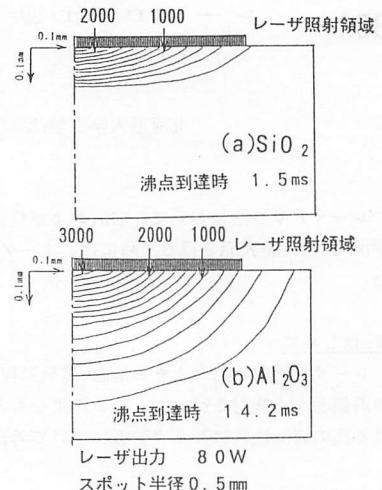


図 2 Si<sub>2</sub>およびAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ターゲットにおける温度分布

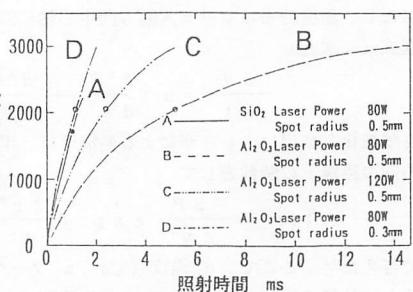
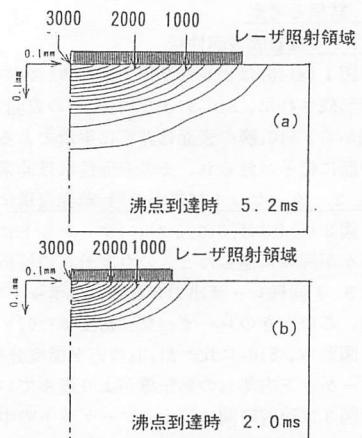


図 3 時間経過に対する中心温度の変化



(a) レーザ出力 120 W (b) レーザ出力 80 W  
スポット半径 0.5 mm ソット半径 0.3 mm  
図 4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ターゲットにおける温度分布